Fiche d'application n° 59 V1

Recherche de dopants dans des zones localisées de semi-conducteurs

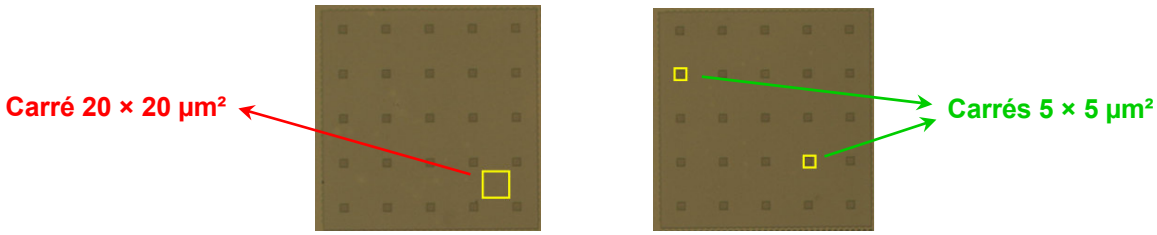
Objet : Recherche de dopants en surface d'un wafer de silicium dans des zones très localisées (échelle micrométrique).

Technique mise en œuvre : SIMS en mode dynamique

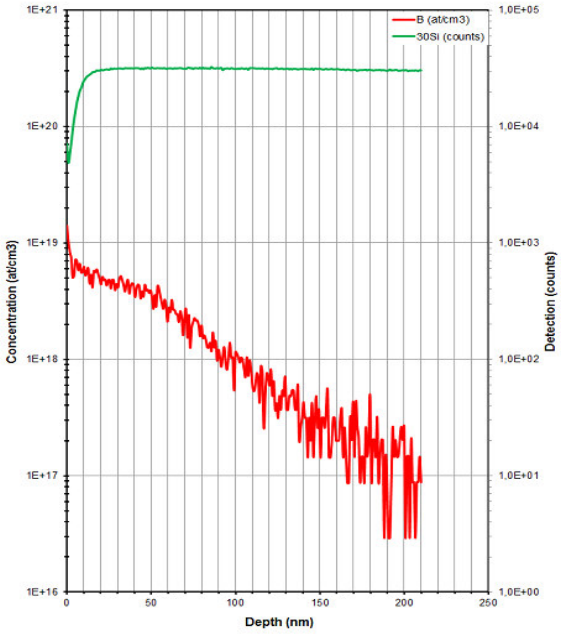
- ✓ Grande sensibilité et bonne résolution latérale
- ✓ Profils de concentration de dopants très localisés

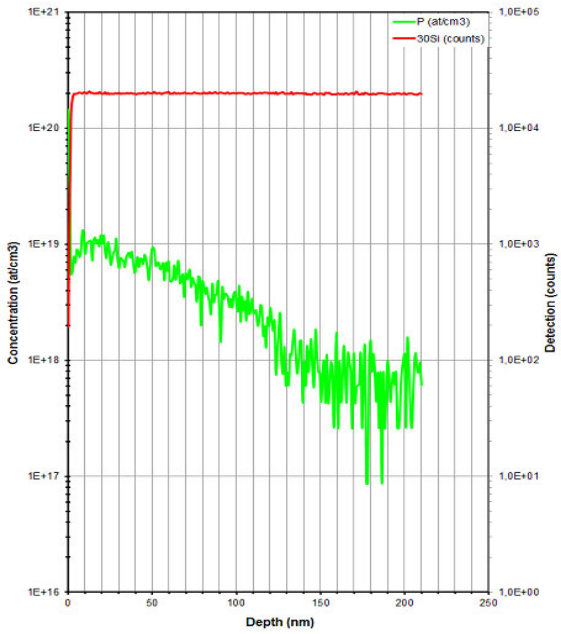
Résultats :

✓ Localisation dans les zones dopées



✓ Identification de la nature des dopants et profils de concentration





Conclusions :

- ✓Dopage P dans les grands carrés (zones 20 × 20 µm²) avec quantification
- ✓Dopage N dans les petits carrés (zones 5 × 5 µm²) avec quantification

SCIENCE et SURFACE - CSAM - 64 chemin des Mouilles - 69134 ECULLY CEDEX
Tel : 04 72 86 00 45 - Fax : 04 72 86 00 46 - contact@science-et-surface.fr - www.science-et-surface.fr